

2SC921

NPN エピタキシャルプレーナ形シリコントランジスタ / NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor

FM チューナ用 / FM Tuner
マイクロディスク / MICRODISK

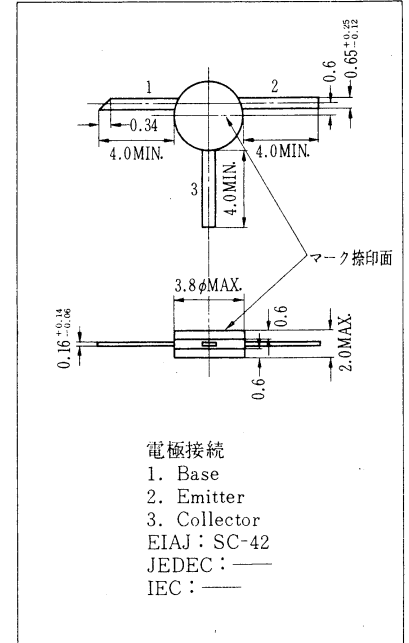
特 徴

- FM チューナ用として最適です。
 f_T : 650MHz TYP., $C_c \cdot r_{b'b}$: 8.0ps TYP., NF : 3.0dB TYP. ($f=100\text{MHz}$)
- 外形が小さいので機器の小形化が可能です。
- マイクロディスク形なので取付時間の節約および自動組立が可能です。
- 自動生産ラインの採用により特性が均一です。

絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	25	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	12	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流	I_C	10	mA
コレクタ損失	P_C	100	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^\circ\text{C}$

外形図 (単位: mm)



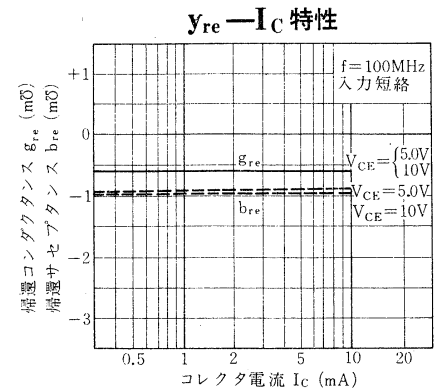
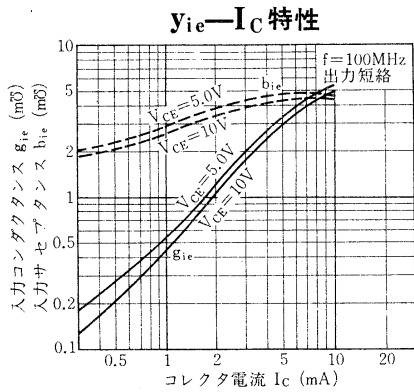
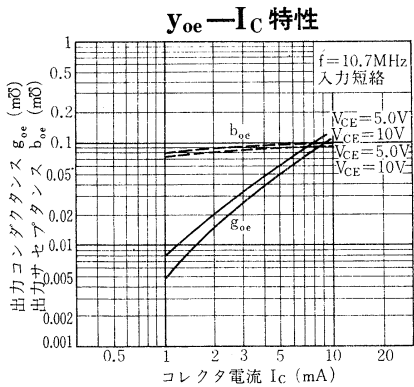
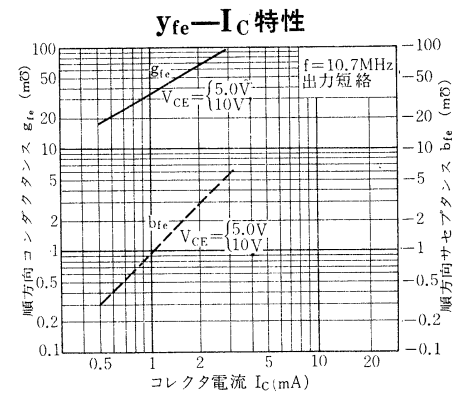
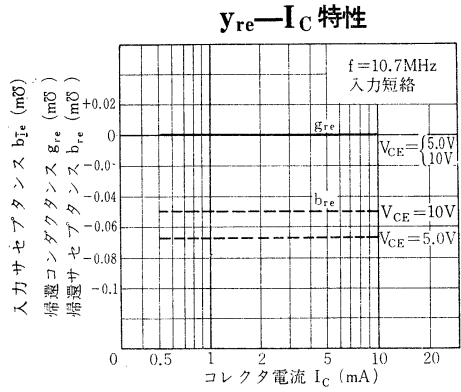
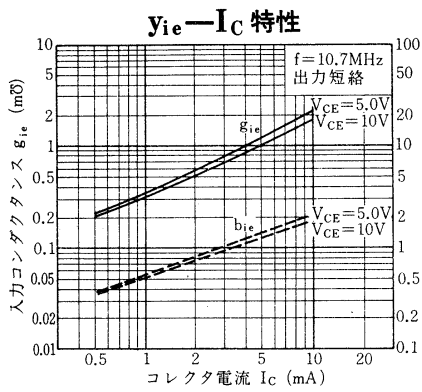
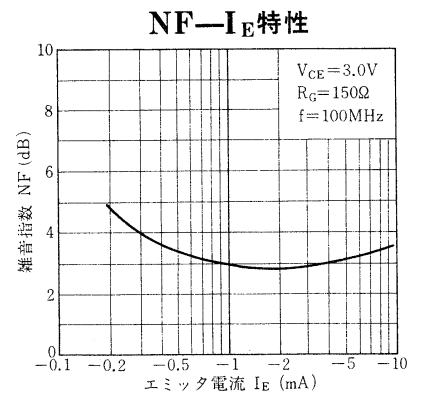
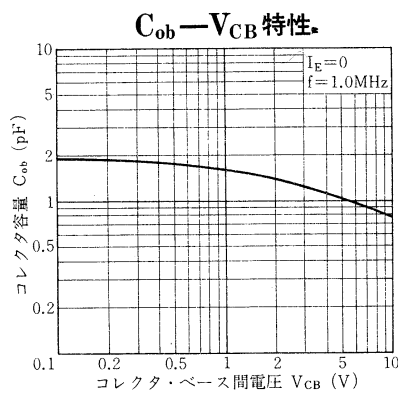
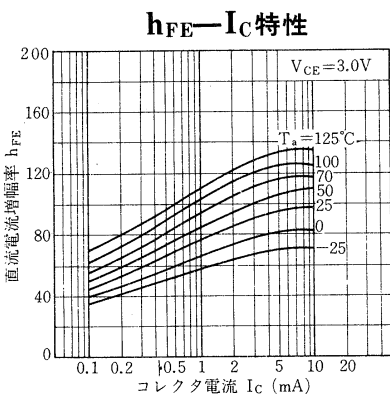
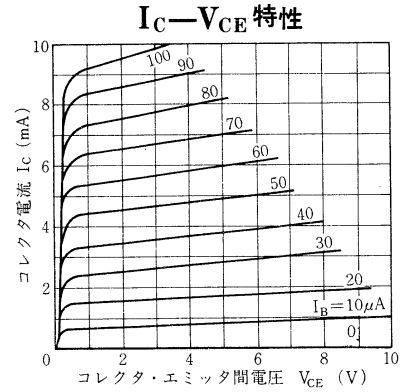
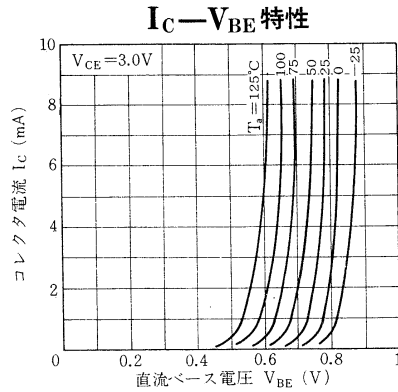
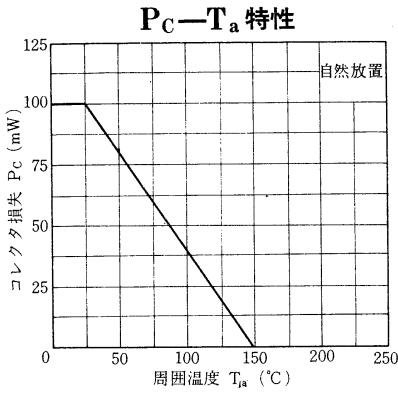
電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=12\text{V}, I_E=0$			0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=2.0\text{V}, I_C=0$			0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=0.5\text{mA}$	30	65	140	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$		0.15	0.60	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}$	450	650		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=6.0\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		0.9	1.5	pF
$C_c \cdot r_{b'b}$ 積	$C_c \cdot r_{b'b}$	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}, f=31.9\text{MHz}$		8.0	12	ps
雑音指数	NF	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}, f=100\text{MHz}, R_G=150\Omega$		3.0	5.0	dB

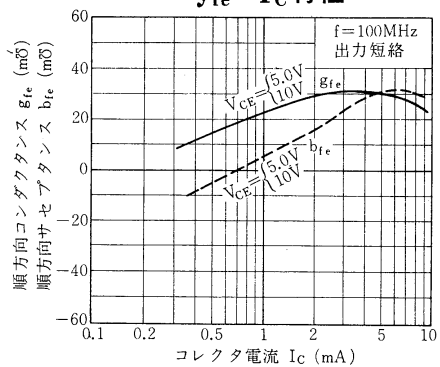
h_{FE} 区分

30~60	45~90	70~140
-------	-------	--------

特性曲線 (T_a=25°C)



$y_{fe}-I_C$ 特性



$y_{oe}-I_C$ 特性

